

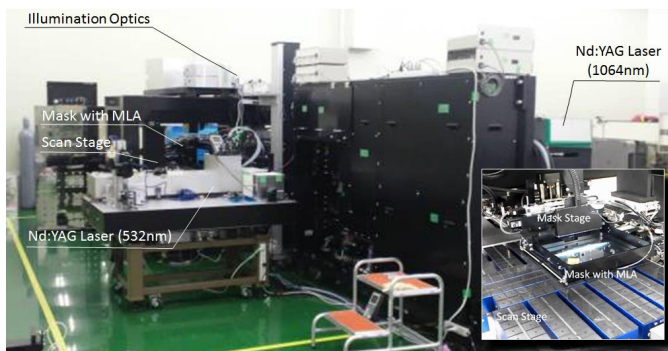
高精度レーザーアニールリング装置

1. 装置概要

直径数百 μm の配列ピッチでアレイ状に形成したマイクロレンズアレイ (MLA) により、選択的に局所レーザーアニール処理することが可能。また、低コストで運用可能な Nd:YAG パルスレーザーを 2 源装備し、電氣的に制御可能なロングパルス化レーザーを搭載している。本装置では、TFT ゲートパターン上などにある a-Si 膜を局所的かつ高い位置精度でレーザー照射を行うことが可能である。

2. メーカー名・装置名称

株式会社ブイ・テクノロジー製・高精度レーザーアニール装置



レーザーアニール装置外観



Nd:YAG レーザー外観

3. 用途

局所的なレーザーアニールリングを行うことが可能。

4. 仕様・構成

- ・ Nd:YAG ロングパルスレーザー（基本波 1064nm）
Nd:YAG ショートパルスレーザー（第二高調波 532nm）
- ・ レーザースクランブル機能によるレーザー光照度面内均一性
- ・ MLA 基板-マスクアライメント機能